

## VOLTAGE DETECTOR

### ■ GENERAL DESCRIPTION

The NJU7700/01 is a low quiescent current voltage detector featuring high precision detection voltage. The detection voltage is fixed internally with an accuracy of 1.0%. NJU7700 is Nch. Open Drain and NJU7701 of output form is a C-MOS output.

### ■ PACKAGE OUTLINE

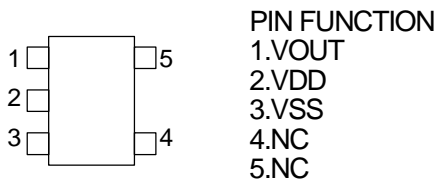


NJU7700/01F

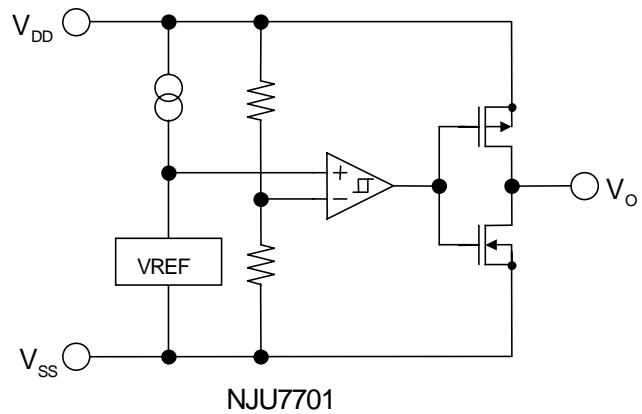
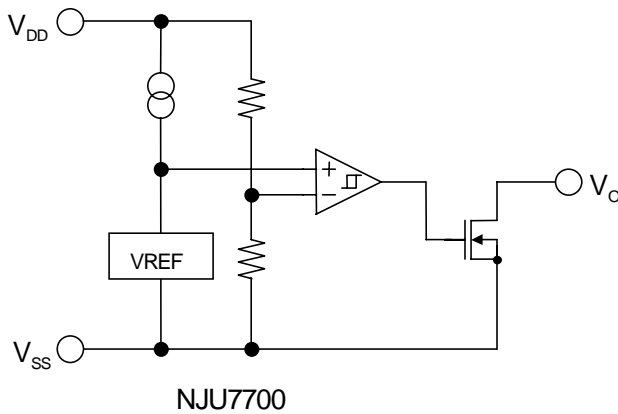
### ■ FEATURES

- High Precision Detection Voltage                     $\pm 1.0\%$
- Low Quiescent Current                                0.8 $\mu$ A typ.
- Detection Voltage Range                            1.3~6.0V(0.1V Step)
- Output Circuit Form                                NJU7700: Nch. Open Drain type  
   NJU7701: C-MOS Output
- Package Outline                                        MTP5 (SOT-23-5)

### ■ PIN CONFIGURATION



### ■ EQUIVALENT CIRCUIT



### ■ DETECTION VOLTAGE RANK LIST

Device Name	V <sub>DET</sub>	Device Name	V <sub>DET</sub>
NJU7700/01F13	1.3V	NJU7700/01F28	2.8V
NJU7700/01F21	2.1V	NJU7700/01F42	4.2V
NJU7700/01F22	2.2V	NJU7700/01F43	4.3V
NJU7700/01F23	2.3V	NJU7700/01F45	4.5V
NJU7700/01F27	2.7V	NJU7700/01F06	6.0V

# NJU7700/01

## ■ NJU7700

### ■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Input Voltage	V <sub>DD</sub>	+10	V
Output Voltage	V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3~+10	V
Output Current	I <sub>OUT</sub>	50	mA
Power Dissipation	P <sub>D</sub>	200	mW
Operating Temperature	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C

### ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
Detection Voltage	V <sub>DET</sub>		-1.0%	-	+1.0%	V	
Hysteresis Voltage	V <sub>HYS</sub>		V <sub>DET</sub> ×0.03	V <sub>DET</sub> ×0.05	V <sub>DET</sub> ×0.08	V	
Quiescent Current	I <sub>SS</sub>	V <sub>DD</sub> =V <sub>DET</sub> +1V	V <sub>DET</sub> =1.3V~1.7V Version	-	0.5	1.0	uA
			V <sub>DET</sub> =1.8V~6.0V Version	-	0.8	1.6	
Output Current	I <sub>OUT</sub>	Nch, V <sub>DS</sub> =0.5V	V <sub>DD</sub> =1.2V	0.75	2.0	-	mA
			V <sub>DD</sub> =2.4V (≥2.7V Version)	4.5	7.0	-	
Output Leak Current	I <sub>LEAK</sub>	V <sub>DD</sub> =V <sub>OUT</sub> =9V	-	-	0.1	uA	
Detection Voltage Temperature Coefficient	Δ V <sub>DET</sub> / ΔTa	Ta=0 ~ +85°C	-	±100	-	ppm/°C	
Operating Voltage (*note 1)	V <sub>DD</sub>	R <sub>L</sub> =100kΩ	0.8	-	9	V	

\*note 1 : The minimum Operating Voltage(V<sub>OPL</sub>) indicates the same value of the output voltage(V<sub>OUT</sub>) on condition that V<sub>OUT</sub> becomes 10% or less of the input voltage(V<sub>DD</sub>).

■ NJU7701

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Input Voltage	V <sub>DD</sub>	+10	V
Output Voltage	V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>DD</sub> +0.3	V
Output Current	I <sub>OUT</sub>	50	mA
Power Dissipation	P <sub>D</sub>	200	mW
Operating Temperature	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
Detection Voltage	V <sub>DET</sub>		-1.0%	—	+1.0%	V	
Hysteresis Voltage	V <sub>HYS</sub>		V <sub>DET</sub> ×0.03	V <sub>DET</sub> ×0.05	V <sub>DET</sub> ×0.08	V	
Quiescent Current	I <sub>SS</sub>	V <sub>DD</sub> =V <sub>DET</sub> +1V	V <sub>DET</sub> =1.3V~1.7V Version	—	0.5	1.0	μA
			V <sub>DET</sub> =1.8V~6.0V Version	—	0.8	1.6	
Output Current	I <sub>OUT</sub>	Nch, V <sub>DS</sub> =0.5V	V <sub>DD</sub> =1.2V	0.75	2.0	—	mA
			V <sub>DD</sub> =2.4V (≥2.7V Version)	4.5	7.0	—	
		Pch, V <sub>DS</sub> =0.5V	V <sub>DD</sub> =4.8V (≤3.9V Version)	2.0	3.5	—	
			V <sub>DD</sub> =6.0V (4.0V~5.6V Version)	2.5	4.0	—	
			V <sub>DD</sub> =8.4V (≥5.7V Version)	3.0	5.0	—	
Detection Voltage Temperature Coefficient	Δ V <sub>DET</sub> / ΔTa	Ta=0 ~ +85°C	—	±100	—	ppm/°C	
Operating Voltage (*note 1)	V <sub>DD</sub>	R <sub>L</sub> =100kΩ	0.8	—	9	V	

\*note 1 : The minimum Operating Voltage(V<sub>OPL</sub>) indicates the same value of the output voltage(V<sub>OUT</sub>) on condition that V<sub>OUT</sub> becomes 10% or less of the input voltage(V<sub>DD</sub>).

**[CAUTION]**

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.